

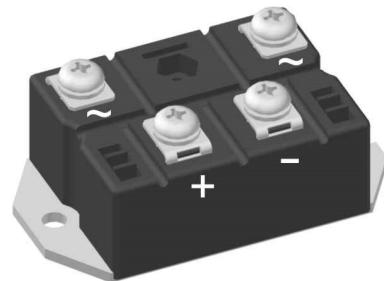
Standard Rectifier Module

1~ Rectifier	
V_{RRM}	= 800 V
I_{DAV}	= 160 A
I_{FSM}	= 2800 A

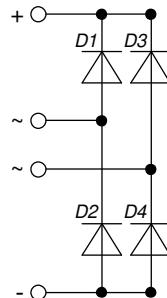
1~ Rectifier Bridge

Part number

VBO160-08NO7



 E72873



Features / Advantages:

- Package with DCB ceramic
- Improved temperature and power cycling
- Planar passivated chips
- Very low forward voltage drop
- Very low leakage current

Applications:

- Diode for main rectification
- For one phase bridge configurations
- Supplies for DC power equipment
- Input rectifiers for PWM inverter
- Battery DC power supplies
- Field supply for DC motors

Package: PWS-E

- Isolation Voltage: 3000 V~
- Industry standard outline
- RoHS compliant
- Easy to mount with two screws
- Base plate: Copper internally DCB isolated
- Advanced power cycling

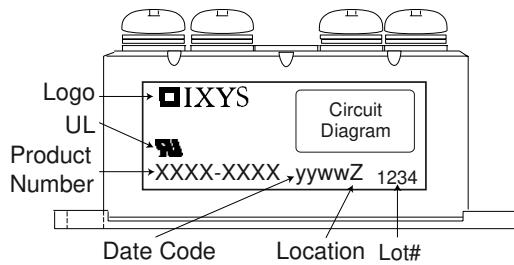
Disclaimer Notice

Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at www.littelfuse.com/disclaimer-electronics.

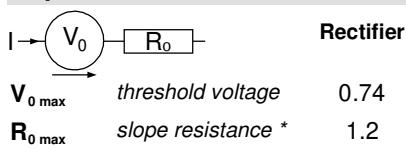
Rectifier

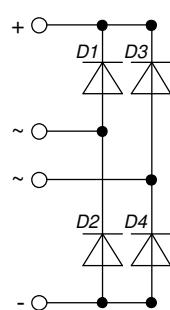
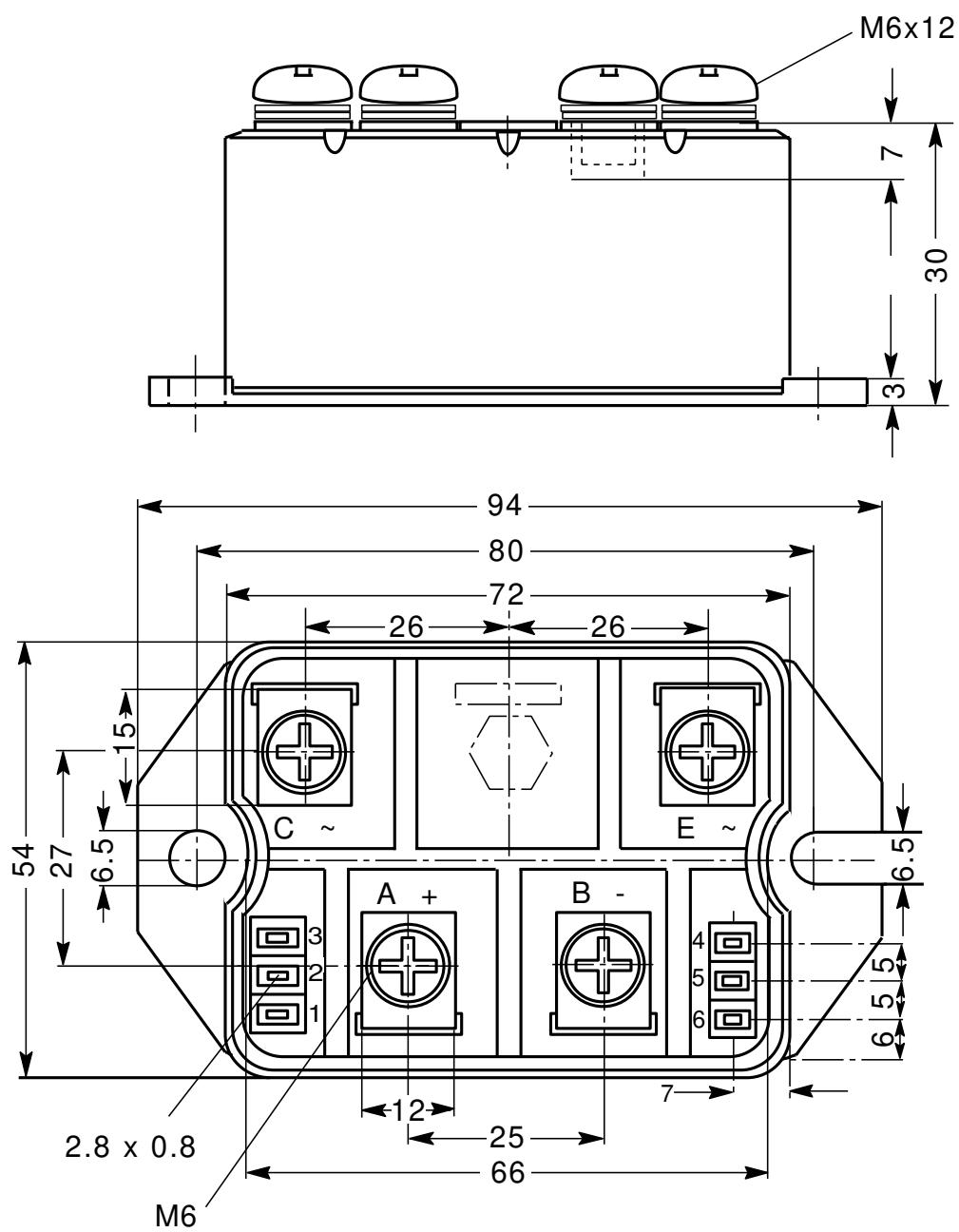
Symbol	Definition	Conditions	Ratings			
			min.	typ.	max.	
V_{RSM}	max. non-repetitive reverse blocking voltage	$T_{VJ} = 25^\circ C$			900	V
V_{RRM}	max. repetitive reverse blocking voltage	$T_{VJ} = 25^\circ C$			800	V
I_R	reverse current	$V_R = 800 V$ $V_R = 800 V$	$T_{VJ} = 25^\circ C$ $T_{VJ} = 150^\circ C$		200 3.5	μA mA
V_F	forward voltage drop	$I_F = 160 A$ $I_F = 320 A$ $I_F = 160 A$ $I_F = 320 A$	$T_{VJ} = 25^\circ C$ $T_{VJ} = 125^\circ C$		1.07 1.22 0.96 1.15	V V
I_{DAV}	bridge output current	$T_C = 110^\circ C$ rectangular $d = 0.5$	$T_{VJ} = 150^\circ C$		160	A
V_{F0} r_F	threshold voltage slope resistance } for power loss calculation only		$T_{VJ} = 150^\circ C$		0.74 2.4	V $m\Omega$
R_{thJC}	thermal resistance junction to case				0.4	K/W
R_{thCH}	thermal resistance case to heatsink			0.15		K/W
P_{tot}	total power dissipation		$T_C = 25^\circ C$		310	W
I_{FSM}	max. forward surge current	$t = 10 \text{ ms}; (50 \text{ Hz}), \text{sine}$ $t = 8,3 \text{ ms}; (60 \text{ Hz}), \text{sine}$ $t = 10 \text{ ms}; (50 \text{ Hz}), \text{sine}$ $t = 8,3 \text{ ms}; (60 \text{ Hz}), \text{sine}$	$T_{VJ} = 45^\circ C$ $V_R = 0 V$ $T_{VJ} = 150^\circ C$ $V_R = 0 V$		2.80 3.03 2.38 2.57	kA kA kA kA
I^2t	value for fusing	$t = 10 \text{ ms}; (50 \text{ Hz}), \text{sine}$ $t = 8,3 \text{ ms}; (60 \text{ Hz}), \text{sine}$ $t = 10 \text{ ms}; (50 \text{ Hz}), \text{sine}$ $t = 8,3 \text{ ms}; (60 \text{ Hz}), \text{sine}$	$T_{VJ} = 45^\circ C$ $V_R = 0 V$ $T_{VJ} = 150^\circ C$ $V_R = 0 V$		39.2 38.1 28.3 27.5	kA^2s kA^2s kA^2s kA^2s
C_J	junction capacitance	$V_R = 400 V; f = 1 \text{ MHz}$	$T_{VJ} = 25^\circ C$		133	pF

Package PWS-E			Ratings			
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
I_{RMS}	RMS current	per terminal			250	A
T_{VJ}	virtual junction temperature		-40		150	°C
T_{op}	operation temperature		-40		125	°C
T_{stg}	storage temperature		-40		125	°C
Weight				273		g
M_D	mounting torque		4.25		5.75	Nm
M_T	terminal torque		4.25		5.75	Nm
$d_{Spp/App}$	creepage distance on surface / striking distance through air		terminal to terminal	12.0		mm
$d_{Spb/Apb}$			terminal to backside	26.0		mm
V_{ISOL}	isolation voltage	$t = 1$ second $t = 1$ minute	50/60 Hz, RMS; $I_{ISOL} \leq 1$ mA	3000		V
				2500		V



Ordering	Ordering Number	Marking on Product	Delivery Mode	Quantity	Code No.
Standard	VBO160-08NO7	VBO160-08NO7	Box	5	475785

Equivalent Circuits for Simulation
* on die level
 $T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$


Outlines PWS-E


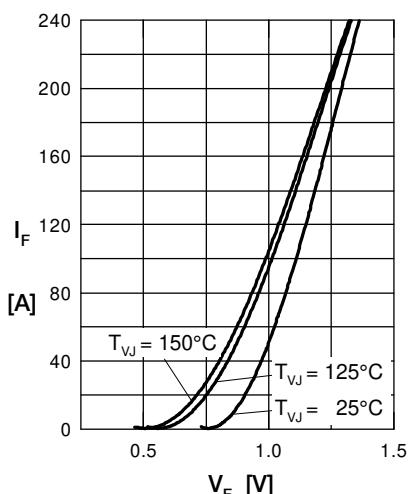
Rectifier


Fig. 1 Forward current vs.
voltage drop per diode

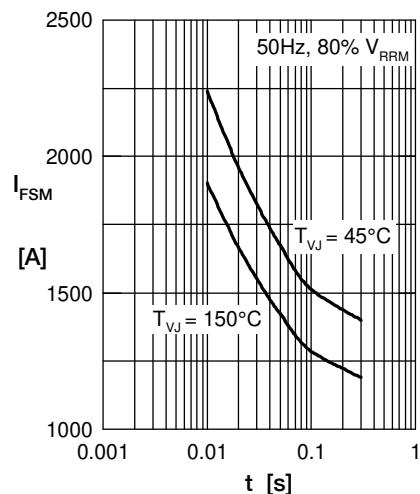


Fig. 2 Surge overload current
vs. time per diode

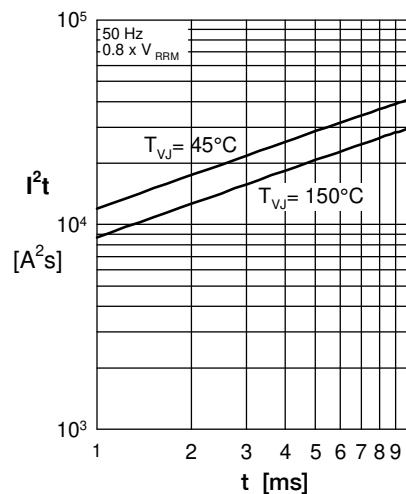


Fig. 3 I^2t vs. time per diode

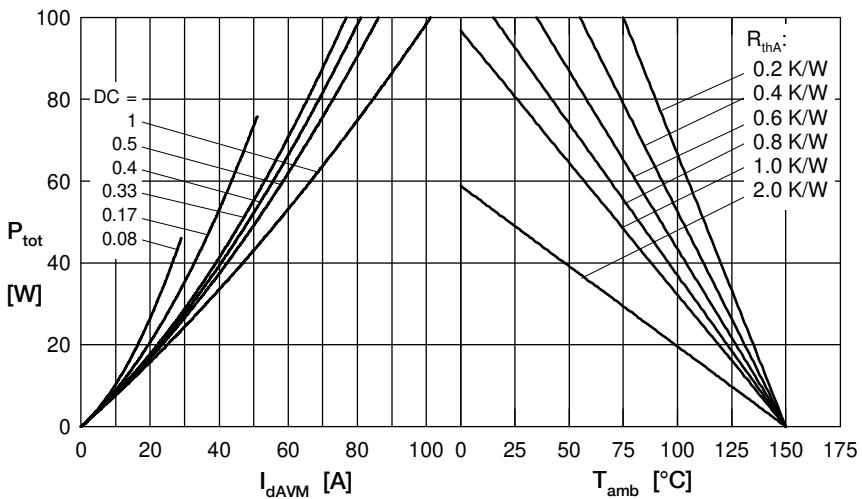


Fig. 4 Power dissipation vs. forward current
and ambient temperature per diode

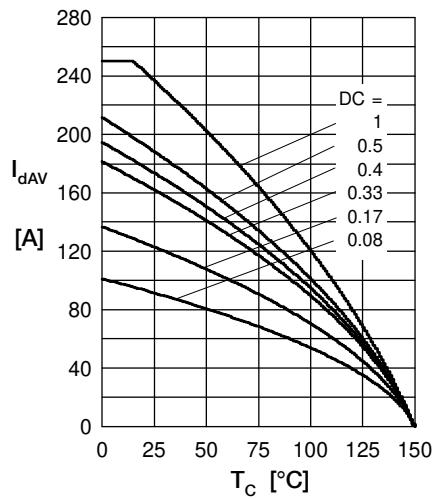


Fig. 5 Max. forward current vs.
case temperature per diode

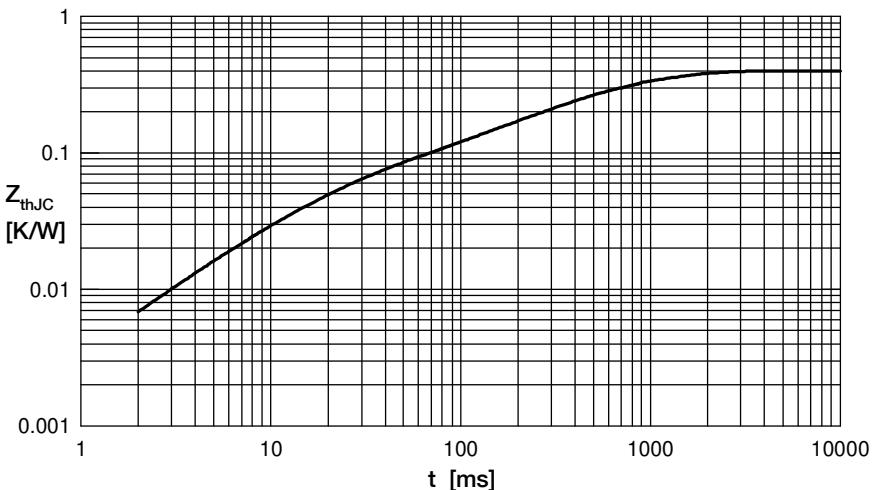


Fig. 6 Transient thermal impedance junction to case vs. time per diode

R_i	t_i
0.050	0.02
0.003	0.01
0.100	0.225
0.177	0.8
0.070	0.58

Данный компонент на территории Российской Федерации**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибуторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р В 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru
moschip.ru_4

moschip.ru_6
moschip.ru_9